

Étude de lasers a base des composes semi-conducteurs

Said DEHIMI

Soutenu en: 2012

Abstract : L'objectif de ce travail est l'étude des lasers à base d'hétérojonctions de semi-conducteur IIIV. L'étude du dispositif laser à semi-conducteur GaAs-AlGaAs (notion de base du lasers et propriété optoélectronique) qui se limite au régime stationnaire du laser présenté. La simulation par la partie laser du logiciel de simulateur SILVAC-ATLAS a permis d'éclaircir l'influence de quelque paramètre du laser étudié.

Keywords : laser, semi-conducteur, diode, simulation, SILVACO-ATLAS